

Panier De Nettoyage Personnalisé En Ptfé Pour Wafers Semi-Conducteurs, Résistant À La Corrosion, Support De Laboratoire À Faible Bruit De Fond

Numéro d'article: PL-CP267



Introduction

Atteignez une pureté supérieure dans la fabrication des semi-conducteurs avec nos paniers de nettoyage personnalisés en PTFE. Conçus pour une résistance chimique extrême et une faible interférence de fond, ces supports durables assurent un traitement efficace des wafers, un drainage rapide et des performances fiables dans les environnements de laboratoire critiques à haute pureté.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage Clé
Processus de Nettoyage RCA	Utilisé pendant les séquences SC-1 et SC-2 pour éliminer les résidus organiques et les contaminants métalliques des wafers de silicium.	Empêche la re-contamination grâce à la surface du matériau ultra-pur et à faible lessivage.
Gravure Piranha	Manipulation des wafers dans un mélange d'acide sulfurique et de peroxyde d'hydrogène pour l'élimination de la photorésine.	Résistance exceptionnelle aux environnements oxydatifs agressifs sans dégradation structurelle.
Trempe à l'Acide Fluorhydrique	Élimination des couches d'oxyde natif des substrats de silicium à l'aide de solutions HF concentrées ou tamponnées.	Immunité totale à l'attaque du HF, assurant la survie à long terme de l'équipement et la pureté du processus.
Rinçage Post-CMP	Nettoyage des wafers après le polissage chimico-mécanique pour éliminer les particules de boue et les produits chimiques.	Le drainage rapide et les propriétés anti-adhésives empêchent les particules de boue d'adhérer au panier.
Développement Photolithographique	Support des substrats pendant le développement et le décapage des couches de photorésine.	La haute stabilité dimensionnelle assure un alignement et une manipulation précis pendant les étapes critiques de lithographie.
Préparation pour l'Analyse de Traces	Nettoyage de la verrerie et des conteneurs utilisés dans les techniques analytiques à haute sensibilité comme l'ICP-MS.	Des niveaux de fond extrêmement bas garantissent la plus grande précision dans la détection des impuretés métalliques traces.
Traitement des Wafers GaAs	Manipulation des wafers de semi-conducteurs composés à travers des cycles de gravure et de rinçage spécialisés.	Les structures de support douces préviennent la rupture des matériaux semi-conducteurs composés fragiles.
Nettoyage Ultrasonique	Fonctionne comme un support immergé pendant les cycles de nettoyage acoustique haute fréquence.	Transmet efficacement l'énergie ultrasonique tout en protégeant les wafers du contact mécanique avec la cuve.

Caractéristique	Détails des Spécifications pour PL-CP267
Identifiant du Modèle	PL-CP267
Matériau Principal	PTFE (Polytétrafluoroéthylène) Vierge Haute Pureté
Processus de Fabrication	100% Usiné CNC de Précision (Pas de résidus de moulage par injection)
Résistance Chimique	Résistance totale au HF, H2SO4, HNO3, HCl, KOH et Solvants Organiques
Plage de Température	-200°C à +260°C (-328°F à +500°F)
Finition de Surface	Finition lisse et à faible porosité pour minimiser la rétention des particules

Application	Description	Avantage Clé
Caractéristique	Détails des Spécifications pour PL-CP267	
Options de Configuration	Entièrement Personnalisable (Taille des wafers, largeur des fentes, pas des fentes, conception de la poignée)	
Compatibilité des Wafers	Adapté aux wafers de 2", 3", 4", 6", 8" et 12" ou dimensions personnalisées	
Conception du Drainage	Profils de fentes en V ou en U disponibles pour un écoulement des fluides optimisé	
Niveaux de Fond	Spécifiquement traité pour répondre aux exigences d'impuretés métalliques inférieures à la partie par milliard (ppb)	